



济南市半导体元件实验所

# 瞬态电压抑制二极管阵列系列产品

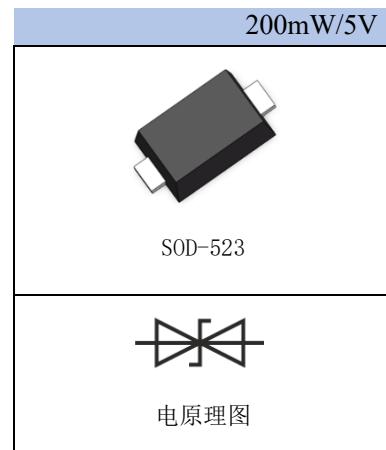
## ZL8D16S3P 型瞬态电压抑制二极管阵列

### 1 特性

- 采用外延平面结构；
- 低电容，响应速度快；
- 静电敏感等级：非敏感；
- 封装外形：SOD-523。

### 2 质量等级及执行标准

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| G 级：QZJ840611、Q/RBJ1016QZ | G+：Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A |
| J 级：Q/RBJ-GL-02JS-01A     |                                  |



### 3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

| 参数<br>产品型号 | $P_{PPM}$<br>$t_p=8/20 \mu\text{s}$<br>mW | $I_{PP}$<br>$t_p=8/20 \mu\text{s}$<br>A | $V_{RWM}$<br>V | $T_{OP}$<br>°C | $T_j$<br>°C | $T_{stg}$<br>°C |
|------------|---|---|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| ZL8D16S3P  | 200                                       | 5.0                                     | 5.0            | -55~125        | -55~150     | -55~150         |

### 4 主要电特性

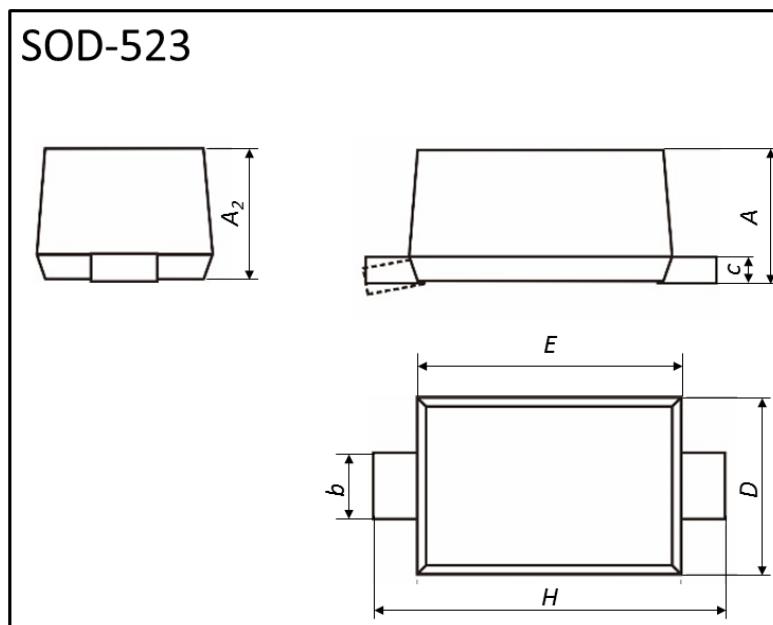
主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

| 序号 | 参数符号     | 测试条件                     | 数值  |     |     | 单位            |
|----|----------|--------------------------|-----|-----|-----|---------------|
|    |          |                          | 最小值 | 典型值 | 最大值 |               |
| 1  | $V_{BR}$ | $I_R=1.0\text{mA}$       | 5.6 | —   | 8.2 | V             |
| 2  | $V_C$    | $I_{PP}=5.0\text{A}$     | —   | —   | 11  | V             |
| 3  | $I_R$    | $V_R=\pm 5.0\text{V}$    | —   | —   | 1.0 | $\mu\text{A}$ |
| 4  | $C_j$    | $V_F=0, f=1.0\text{MHz}$ | —   | 13  | —   | pF            |



## 5 外形尺寸图



单位:mm

| 尺寸 \ 符号 | A    | $A_2$ | b    | c    | D    | E    | H    |
|---------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 最小值     | 0.51 | 0.50  | 0.25 | 0.08 | 0.64 | 1.00 | 1.35 |
| 最大值     | 0.74 | 0.70  | 0.38 | 0.17 | 0.96 | 1.40 | 1.85 |

图1 SOD-523 外形尺寸图